

В 1 см^3 за 1 с электрич. поле совершает над электронами работу $eE v_n n_e = jE = \sigma E^2$. Это есть джоулево тепло тока, передаваемое электронами газу при столкновениях. Упругая передача в одном эфф. столкновении составляет долю $\delta = 2m/M$ от энергии электрона ϵ (M — масса атома); $\delta \sim 10^{-4} - 10^{-3}$. В молекулярном газе электрон гораздо больше тратит на возбуждение колебаний молекул; $\delta \sim 10^{-3}$. Ср. энергия электрона $\bar{\epsilon}$ соответствует балансу между приобретением и передачей энергии газу; баланс устанавливается очень быстро, за время $\tau = (v_n \delta)^{-1}$. При не зависящем от энергии транспортном сечении $\sigma_m(\epsilon) = \text{const}$ и максвелловском распределении скоростей \bar{v} ср. энергия $\bar{\epsilon} = (\sqrt{3\pi/4} e E l / \sqrt{\delta})$; $v_n \bar{v} = (\sqrt{3\pi/4}) \sqrt{\delta} \ll 1$. Действует закон подобия: $\bar{\epsilon} \sim E/N$. В положит. столбе глеющего разряда $E/p \sim 1 - 10 \text{ В/см} \cdot \text{тор}$, а $\bar{\epsilon} = 3kT_e/2 \approx 1 - 3 \text{ эВ}$. Когда частота электрон-электронных столкновений много меньше $v_n \delta$, электронный спектр далёк от максвелловского и T_e имеет условный смысл. Более строгие выражения для v_n , $\bar{\epsilon}$ и др. параметров находят, решая кинетич. ур-ние для ф-ции распределения электронов по скоростям $f(v)$.

Образование и гибель заряженных частиц в электрическом поле. Атомы и молекулы ионизируются гл. обр. ударами электронов (см. *Ионизация*), в слабоионизованной неравновесной плазме — преим. из осн. состояния. Зная сечение ионизации $\sigma_i(\epsilon)$ и ф-цию распределения электронов, можно вычислить частоту ионизации v_i — число ионизаций, совершаемых электроном в 1 с . Вблизи порога (ионизационного потенциала I) $\sigma_i = C_i(\epsilon - I)$. При максвелловском распределении имеем:

$$v_i = N \bar{v} C_i (I + 2kT_e) \exp(-I/kT_e); \quad \bar{v} = (8kT_e/\pi m)^{1/2}. \quad (1)$$

Константы C_i для разных газов различаются в 2—3 раза. Для Ag, напр., $C_i = 2 \cdot 10^{-17} \text{ см}^2/\text{эВ}$. В случае пост. поля удобнее оперировать ионизац. коэф. α — числом ионизаций, к-рые электрон совершает на 1 см дрейфового пути вдоль поля: $\alpha = v_i/v_d$. Обычно экспериментально измеряют α и v_d , а не v_i . Для этих параметров также существует закон подобия: $\alpha/N, v_i/N$ — ф-ции E/N (рис. 2). Для определения α широко используется полуэмпирич. ф-ла Таунсенда:

$$\alpha = A \exp(-Bp/E), \quad (2)$$

постоянные A и B к-рой находят либо из опыта (для больших E/p), либо на основе решения кинетич. ур-ния (при низких E/p). Напр., в N_2 для $E/p \approx 100 - 600 \text{ В/(см} \cdot \text{тор)}$ $A \approx 12 \text{ см}^{-1} \cdot \text{тор}^{-1}$, $B \approx 342 \text{ В/(см} \cdot \text{тор)}$; при $E/p \approx 10 - 100 \text{ В/(см} \cdot \text{тор)}$ $A \approx 10$, $B \approx 275$.

$\alpha/p, \text{ см}^{-1} \cdot \text{тор}^{-1}$

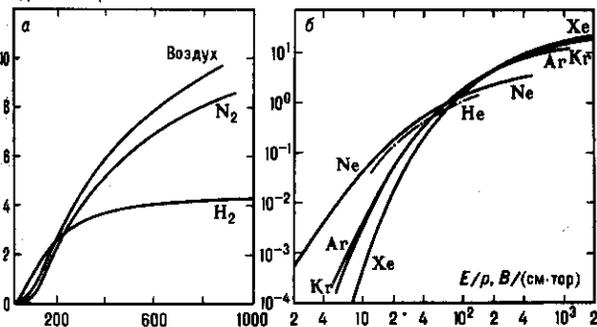


Рис. 2. Ионизационные коэффициенты α ; а — для воздуха, азота и водорода; б — для инертных газов.

Ионизация может быть и ступенчатой: первым электронным ударом атом лишь возбуждается, а ионизируется следующим или после повторного возбуждения. При объединении возбуждённых атомов может произойти ассоциативная ионизация (напр., $\text{Hg}^* + \text{Hg}^* \rightarrow \text{Hg}_2^+ + e$).

Заряды из плазмы исчезают в результате *рекомбинации* в объёме или на стенках. При низкой темп-ре газа элек-

тронная рекомбинация в объёме идёт преим. диссоциативным механизмом типа $N_2^+ + e \rightarrow N + N$ с коэф. $\beta \sim 10^{-7} - 10^{-8} \text{ см}^3/\text{с}$ (в инертных газах после предварит. реакции конверсии типа $\text{He}^+ + \text{He} + \text{He} \rightarrow \text{He}_2^+ + \text{He}$). Частота рекомбинации $v_r = \beta n_+$. При $p < 10$ тор преобладает амбиполярная (совместная) диффузия электронов и ионов с частотой $v_d = D_a/\Lambda^2$ к стенкам, где они и нейтрализуются. При $T_e \gg T$ коэф. амбиполярной диффузии $D_a = \mu_+ T_e$ (в азоте, напр., $D_a \approx 1,5 \cdot 10^3/p \text{ см}^2/\text{с}$; T_e в В, p в тор), Λ — диффузионная длина. В длинной трубке $\Lambda = R/2,4$.

В электроотрицат. газах (O_2, CO_2 , галогенах, их смесях и др.) происходит *прилипание* электронов с образованием отрицат. ионов. Скорость прилипания характеризуется частотой $v_a [\text{с}^{-1}]$ и коэф. $a [\text{см}^{-1}]$, аналогичным α . Под ударами возбуждённых частиц электроны могут отлипать от отрицат. ионов. Коэф. α нарастает с увеличением E/p быстрее, чем a , поэтому кривые $\alpha(E)$ и $a(E)$ пересекаются [напр., в воздухе — при $E/p = 31 \text{ В/(см} \cdot \text{тор)} = 23,6 \text{ кВ/(см} \cdot \text{атм)}$]. При меньшем E/p в отсутствие отлипания ионизация в воздухе идти не может. В отсутствие поля прилипание идёт в тройных столкновениях типа $e + \text{O}_2 + \text{O}_2 \rightarrow \text{O}_2^- + \text{O}_2$; в воздухе при $p = 1 \text{ атм}$ частота прилипания $v_a \approx 10^7 - 10^8 \text{ с}^{-1}$, т. е. электрон живёт $10^{-7} - 10^{-8} \text{ с}$. Положит. и отрицат. ионы в воздухе при атм. условиях рекомбинируют с коэф. $\beta \approx 2 \cdot 10^{-6} \text{ см}^3/\text{с}$.

В равновесной плазме при $T \sim 10^4 \text{ К}$ и $p \sim 1 \text{ атм}$ преобладают ступенчатая ионизация и электрон-ионная рекомбинация в тройных столкновениях, но n_e однозначно определяется T и p — ур-нием Саха.

Пробой. Плоский промежуток длиной d в пост. поле $E = V/d$ при $pd < 200 - 1000 \text{ тор} \cdot \text{см}$ пробивается путём размножения лавин через вторичную эмиссию. От каждого электрона, вышедшего с катода, рождается $\exp(\alpha d) - 1$ электрон-ионных пар. Попад на катод, ион выбивает из него γ вторичных электронов (коэф. эмиссии $\gamma \sim 10^{-1} - 10^{-3}$). Если вторичных электронов будет больше, чем первичных, ионизация будет неуклонно нарастать и произойдёт пробой. Порог пробоя или потенциал зажигания разряда V_i определяется из условия Таунсенда:

$$\gamma [\exp(\alpha d) - 1] = 1; \quad \alpha(E_i) d = \ln(\gamma^{-1} + 1); \quad E_i = V_i/d. \quad (3)$$

С учётом (2)

$$V_i = B(pd) / [C + \ln(pd)], \quad C = \ln \{ A / [\ln(\gamma^{-1} + 1)] \}. \quad (4)$$

Эта ф-ла неплохо описывает эксперим. кривые Пашена (рис. 3), имеющие минимум при следующих параметрах:

$$V_{i, \text{min}} = \frac{\bar{e} B}{A} \ln(\gamma^{-1} + 1), \quad \left(\frac{E}{p}\right)_{\text{min}} = B, \quad (pd)_{\text{min}} = \frac{\bar{e}}{A} \ln(\gamma^{-1} + 1), \quad (5)$$

где \bar{e} — экспонента. В точке минимума кривой Пашена условия по pd оптимальны для размножения электронов.

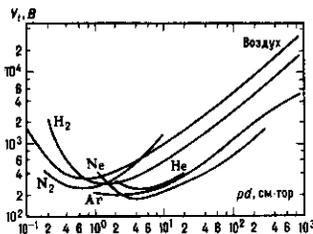


Рис. 3. Потенциалы зажигания в постоянном поле (кривые Пашена).

В осциллирующем поле $E = E_0 \sin \omega t$ электрон совершает колебания: при $v_m \ll \omega$ — свободные, с амплитудой $a = eE_0/m\omega^2$; при $v_m \gg \omega$ — дрейфовые, с $a = \mu_e E_0/\omega$. Если a много меньше характерных размеров разрядного объёма (что типично для СВЧ-диапазона), то лавины локализованы. Ионизация, вызванная случайным электроном, нарастает, если её частота $v_i(E_0)$ превышает частоту диффузии электрона к стенкам $v_d = D_e/\Lambda^2$. В начале процесса зарядов мало и электроны диффундируют свободно с коэф. диффузии $D_e = (\mu_e/\mu_a) D_a \gg D_a$. Пороговое для пробоя среднеквадратичное поле E_i определяется из условия $v_i(E_i) = v_d$;